

Установки предназначены для плавления исходного сырья и выращивания из расплава кристаллов искусственного корунда, используемых в качестве исходного сырья для изготовления подложек при производстве сверхъярких диодов, в микроэлектронике, оптоэлектронике, акустоэлектронике, лазерной тех-

нике, медицине и изделий силовой электроники.

Для выращивания кристаллов используется **МЕТОД КИРОПУЛОСА**.

Преимущества данного метода: высокое качество получаемого продукта, высокая скорость роста кристалла и возможность автоматизации процесса.

**Технические параметры**

Параметры	Апекс -М	Апекс-250
Масса кристалла	27-28 кг	55-56 кг
Наружные размеры тигля	D250×380 мм	D330×450 мм
Материал тигля	вольфрам	вольфрам
Способ нагрева	резистивный	резистивный
Среда в рабочем пространстве: - вакуум, Па - инертный газ, мПа	$6,7 \times 10^{-3}$ 0,05	$6,7 \times 10^{-3}$ 0,05
Скорость вертикального перемещения штока	0,1-2,0 мм/ч	0,1-2,0 мм/ч
Частота вращения штока	0-20 мин <sup>-1</sup>	0-20 мин <sup>-1</sup>
Расход охлаждающей воды, не более	10 м <sup>3</sup> /ч	10 м <sup>3</sup> /ч
Питание силовой части	380 Вт, 50 (60) Гц	380 Вт, 50 (60) Гц
Потребляемая мощность	60 кВт	80 кВт
Питание шкафа управления	220 В	220 В



**Габаритные размеры на установки**

Параметры	Апекс -М	Апекс-250
Высота максимальная	2700 мм	2900 мм
Длина	2400 мм	2400 мм
Ширина	1450 мм	1600 мм

**Контакты**

Открытое акционерное общество «Рыбинский завод приборостроения»  
152907, г. Рыбинск, Ярославской обл., пр. Серова, 89

**Отдел маркетинга**

Тел.: (4855) 28-58-07 Факс: (4855) 28-58-03 E-mail: om@rzp.su.

Сайт: [www.rzp.su](http://www.rzp.su)